

Silicon Super Fast Recovery Diode

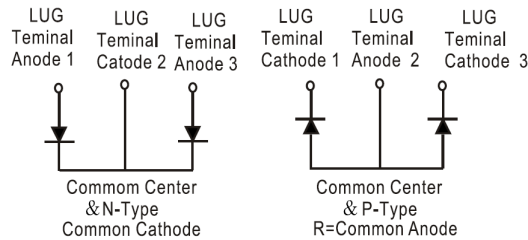
$V_{RRM} = 50 \text{ V} - 200 \text{ V}$

$I_{F(AV)} = 100 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 50 V to 200 V V_{RRM}
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated base plate
- Not ESD Sensitive

Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MURT10005(R)	MURT10010(R)	MURT10020(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	71	141	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MURT10005(R)	MURT10010(R)	MURT10020(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 140^\circ\text{C}$	100	100	100	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3 \text{ ms}$, half sine	1500	1500	1500	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 50 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1.0	1.0	1.0	V
Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25^\circ\text{C}$	25	25	25	μA
		$T_j = 125^\circ\text{C}$	1	1	1	mA
Maximum reverse recovery time (per leg)	T_{rr}	$I_F = 0.5 \text{ A}$, $I_R = 1.0 \text{ A}$, $I_{RR} = 0.25 \text{ A}$	75	75	75	nS

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case (per leg)	$R_{\theta JC}$		1.0	1.0	1.0	$^\circ\text{C/W}$
---	-----------------	--	-----	-----	-----	--------------------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

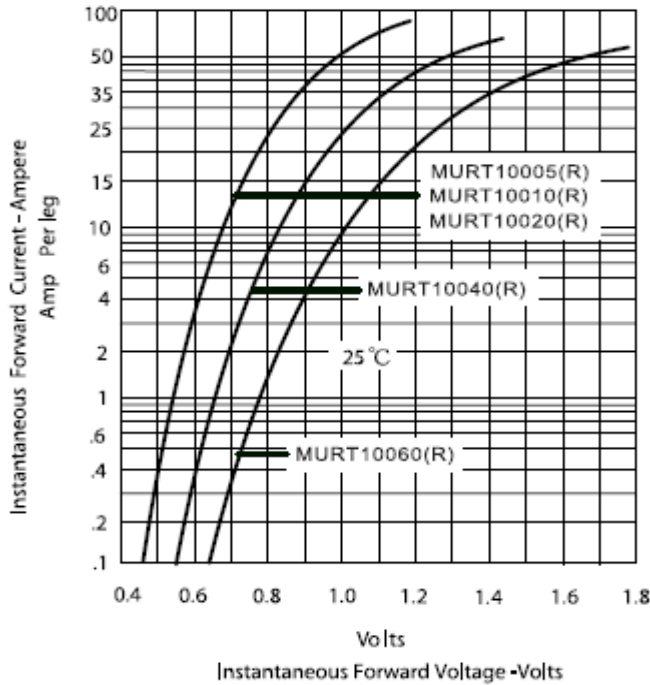


Figure .2- Forward Derating Curve

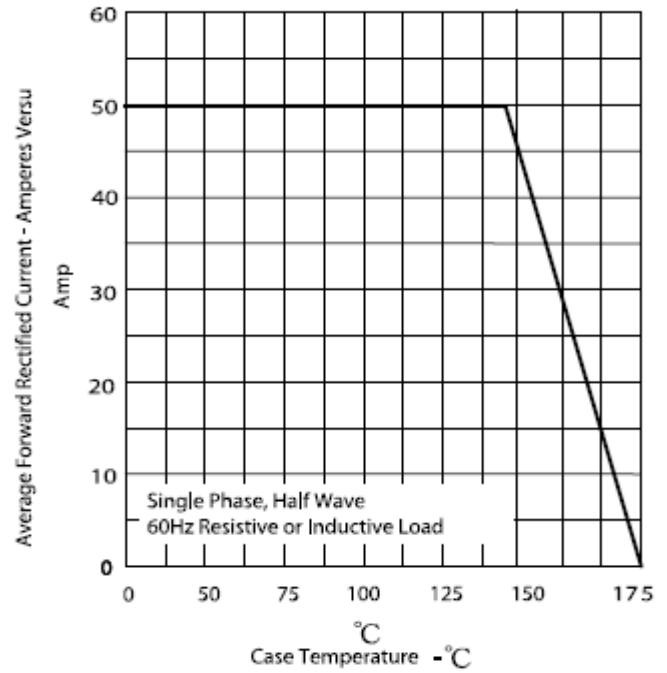


Figure.3- Peak Forward Surge Current

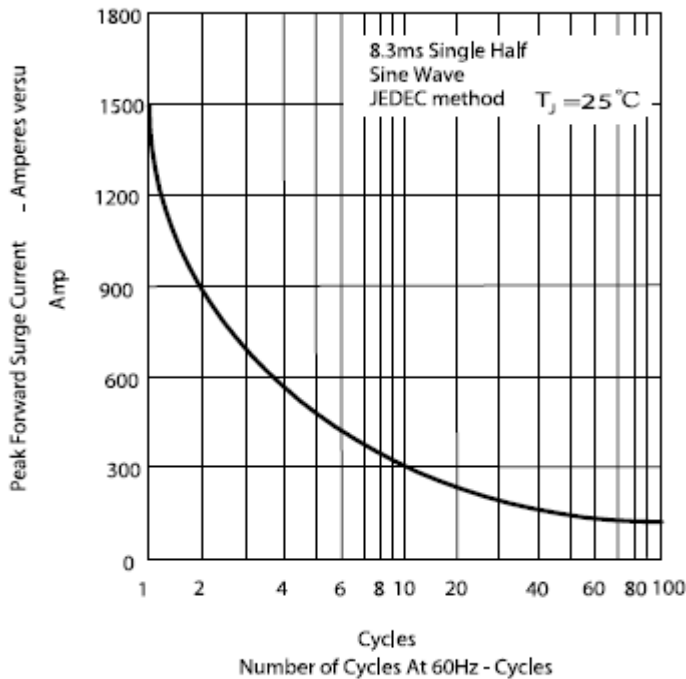
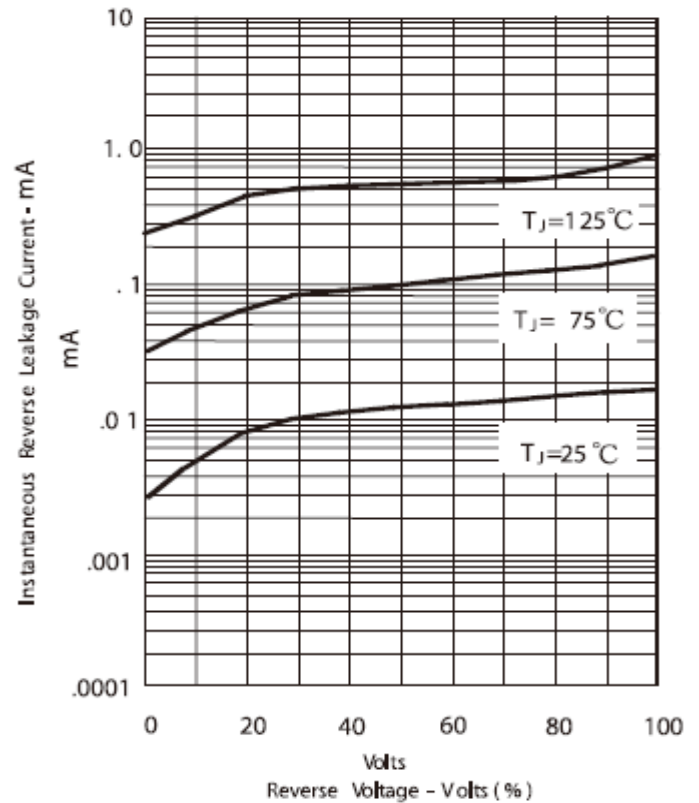
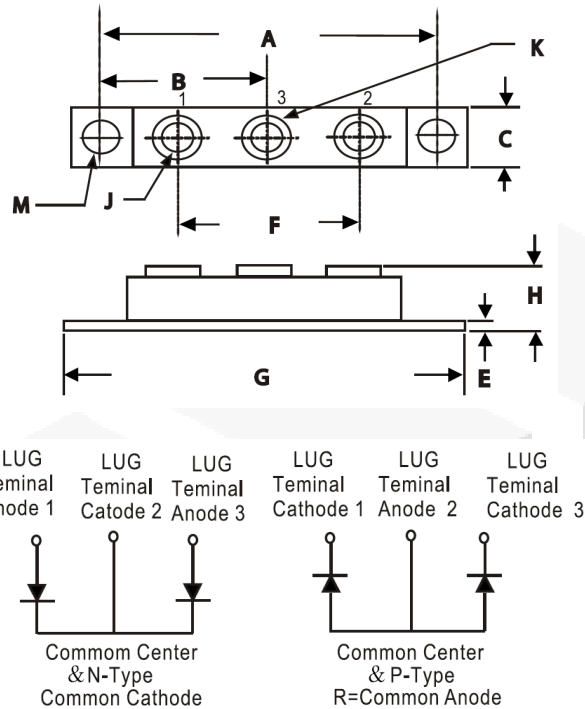


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3.150	NOM	80.01	NOM
B	1.565	1.585	39.75	40.26
C	.700	.800	17.78	20.32
E	.119	.132	3.02	3.35
F	1.327	REF	33.72	REF
G	3.550	3.65	90.17	92.71
H	—	.73	—	18.30
J	1/4-20 UNC FULL			
K	.472	.511	12.00	13.00
M	.275	.295	6.99	7.49
N	2.380	2.46	60.50	62.50

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MURT10005](#) [MURT10005R](#) [MURT10010](#) [MURT10010R](#) [MURT10020](#) [MURT10020R](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9